

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Variasi tekanan gas nitrogen dalam proses deposisi film tipis GaN dengan teknik *spin coating* mempengaruhi nilai potensial *barrier* sistem persambungan *schottky* Al-GaN yang terbentuk. Ketika tekanan gas nitrogen diperbesar dari $0,5 \text{ kgf/cm}^2$ menjadi $1,5 \text{ kgf/cm}^2$, potensial *barrier* menurun dari $0,71 \text{ eV}$ menjadi $0,66 \text{ eV}$.

5.2 Saran

Untuk penelitian yang lebih lanjut penulis menyarankan agar memperbanyak variasi tekanan gas nitrogen untuk mendapatkan kecenderungan yang lebih jelas tentang hubungan antara sifat listrik (tegangan *barrier*) sebagai fungsi tekanan gas nitrogen.